

УДК 537.226.33 : 534.2

## РЕЗОНАНСНАЯ ДИФРАКЦИЯ АКУСТИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН В СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКАХ С КВАЗИРЕГУЛЯРНОЙ ДОМЕННОЙ СТРУКТУРОЙ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

В. И. Альшиц, А. Н. Даринский, А. Л. Шувалов

Рассматривается коллинеарная дифракция звука и света на периодической системе  $180^\circ$  сегнетоэлектрических доменов в электрическом поле, сопровождающаяся резонансной перекачкой доли энергии собственной волны, падающей перпендикулярно доменным стенкам, в волну ортогональной поляризации. Показано, что существенным является учет реально существующего в эксперименте случайного разброса в толщинах доменов вокруг среднего значения («квазирегулярность» доменной структуры). Развита теория приводит к количественному согласию расчета и эксперимента, а также позволяет сделать ряд предсказаний относительно свойств рассматриваемого явления.

Внешнее электрическое поле  $E$  индуцирует пространственно-периодическую модуляцию акустических и оптических свойств кристалла с регулярной структурой  $180^\circ$  сегнетоэлектрических доменов, что обуславливает возможность различных дифракционных явлений. В частности, дифракция света или звука при нормальном падении на регулярную доменную структуру (РДС) в поле  $E$  может приводить на определенных резонансных частотах к возникновению перекачки доли энергии возбуждаемой на входе собственной волны в волну ортогональной поляризации. Это явление рассматривалось в [1]. Результаты акустического эксперимента для  $\text{LiNbO}_3$  с РДС, сформированной из доменов одинаковой толщины, качественно правильно описывались построенной теорией, однако имелись некоторые существенные расхождения между теоретическими и экспериментальными кривыми. В настоящей работе теория из [1] обобщается путем дополнительного учета реально существующего разброса в значениях толщин доменов. При этом удается достичь количественного соответствия расчетных и экспериментальных кривых. Кроме того, такой более общий подход позволяет сформулировать ряд новых предсказаний.

Рассмотрим дифракцию акустических волн. Обозначим через  $A^{(0\alpha)}$ ,  $v^{(0\alpha)}$  ( $\alpha=1, 2, 3$ ) взаимно ортогональные единичные векторы поляризации и фазовые скорости изонормальных собственных волн для направления, ортогонального доменным границам; индекс «0» здесь и далее означает, что данные величины взяты при  $E=0$ . Пусть на входе РДС, состоящей из  $N=2m+1$  доменов<sup>1</sup> толщины  $l_j^{(0)}$  ( $j=1, \dots, N$ ), перпендикулярно к доменным границам возбуждается одна из собственных волн (например,  $\alpha=1$ ) с амплитудой  $C$ . Тогда при  $E \neq 0$  прошедшая через РДС волна содержит наряду с парциальной волной, поляризованной вдоль  $A^{(01)}$ , волны

<sup>1</sup> Чтобы не загромождать выкладки, будем полагать число доменов  $N$  нечетным. Очевидно, что в рассматриваемом случае  $N \geq 1$  это предположение несущественно для приближенных расчетов.

с ортогональными поляризациями  $\mathbf{A}^{(0q)} \perp \mathbf{A}^{(01)}$  ( $q=2, 3$ ). Амплитуды этих волн, согласно [1], задаются приближенным выражением

$$C_q \approx C \xi_{q1} [1 - e^{i(k^{(01)} - k^{(0q)})l_1^{(0)}} (1 + S_q)], \quad (1)$$

где  $k^{(0q)} = \omega/v^{(0q)}$ ;  $\xi_{q1} \sim E$  — вычисленные в [1] малые параметры, которые описывают изменение векторов поляризации собственных волн в поле  $E$ ,

$$S_q = \sum_{p=1}^m \left[ e^{i(k^{(0q)} - k^{(01)}) \left( \sum_{j=2}^{2p+1} l_j^{(0)} \right)} \left( 1 - e^{i(k^{(01)} - k^{(0q)})l_{2p}^{(0)}} \right) \times \right. \\ \left. \times \left( 1 - \frac{v^{(0q)}}{v^{(01)}} e^{i(k^{(01)} - k^{(0q)})l_{2p+1}^{(0)}} \right) \right]. \quad (2)$$

Отметим, что соотношение (1) получено в [1] с помощью линеаризации матричного метода [2, 3] в предположении  $|\xi| N \ll 1$ .

Если положить, что все домены имеют одинаковую толщину  $l_j^{(0)} = l^{(0)}$ , то формулы (1), (2) приводят к результатам, полученным в [1]. Естественное обобщение указанного расчета может быть получено при дополнительном учете «квазирегулярности» реальной доменной структуры, т. е. случайного разброса толщин доменов  $l_j^{(0)}$  вокруг среднего значения  $l^{(0)}$ . Допустим для простоты, что величины  $l_j^{(0)}$  распределены по нормальному закону  $f(l_j^{(0)}) = (\sqrt{2\pi} \sigma)^{-1} \exp[-(l_j^{(0)} - l^{(0)})^2/2\sigma^2]$ . Найдем среднюю интенсивность  $\langle I_q \rangle$  парциальной волны с поляризацией  $\mathbf{A}^{(0q)}$  на выходе РДС.

$$\langle I_q \rangle \equiv \langle C_q C_q^* \rangle = \int_{l_1^{(0)}} \dots \int_{l_N^{(0)}} C_q C_q^* f(l_1^{(0)}) \dots f(l_N^{(0)}) dl_1^{(0)} \dots dl_N^{(0)}, \quad (3)$$

в окрестности резонанса, задаваемого условием

$$\omega_{\text{рез}}/\Omega_q = 1 + 2s \quad (s=0, 1, 2, \dots), \quad (4)$$

где  $\Omega_q = \pi v^{(0q)} v^{(01)} / |v^{(0q)} - v^{(01)}| l^{(0)}$ . В результате вычислений имеем для  $N \gg 1$

$$\frac{\langle I_q \rangle}{I_0} \approx \zeta \left\{ \frac{(\mu_q^4 - 4\epsilon_q^2) \left[ e^{-N\mu_q^2/2} \cos(N\epsilon_q) - 1 \right]}{(\mu_q^4 + 4\epsilon_q^2)^2} + \frac{N\mu_q^2}{2(\mu_q^4 + 4\epsilon_q^2)} \right\}. \quad (5)$$

Здесь

$$I_0 \equiv |C|^2, \quad \zeta \equiv 8\xi_{q1}^2 \left( 1 + \frac{v^{(01)}}{v^{(0q)}} \right)^2, \quad \epsilon_q \equiv \frac{\pi(\omega - \omega_{\text{рез}})}{\Omega_q},$$

$$\mu_q \equiv \frac{\sigma}{l^{(0)}} \frac{\pi\omega}{\Omega_q} \approx \pi \frac{\sigma}{l^{(0)}} (1 + 2s), \quad (6)$$

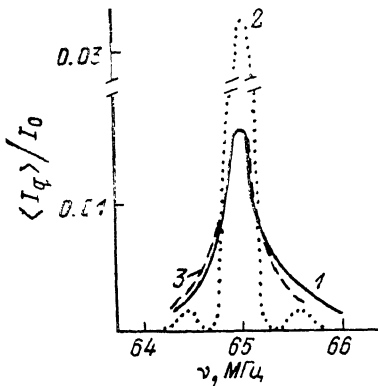
причем  $|\epsilon_q| \ll 1$ ,  $\sigma/l^{(0)} \ll 1$ . На рис. 1 приведено сопоставление данного расчета с экспериментом, выполненным в [1] для  $\text{LiNbO}_3$ . Наилучшее согласие по форме кривой<sup>3</sup> достигается при  $\sigma/l^{(0)} \approx 0.045$ , что приблизительно соответствует реальному разбросу толщин доменов в экспери-

<sup>2</sup> Можно показать, что корреляция величин  $l_j^{(0)}$ , связанная с условием  $\sum_{j=1}^N l_j^{(0)} = L$  ( $L$  — длина кристалла), практически не сказывается на результатах расчета при  $N \gg 1$ .

<sup>3</sup> На рис. 1 высота максимума расчетной кривой при  $\sigma/l^{(0)} \approx 0.045$  отнормирована на эксперимент [1], поскольку в литературе отсутствуют полные данные по измерениям нелинейных коэффициентов в  $\text{LiNbO}_3$ , необходимых для вычисления электроакустического параметра  $\xi$  (см. [1]).

менте [1]. На рис. 1 также приведена теоретическая кривая из [1],<sup>4</sup> задаваемая формулой (5) при условии  $\sigma=0$ , т. е. в предположении идеальной регулярности доменной структуры. Видно, что случайный разброс толщин доменов вокруг среднего значения приводит к исчезновению нулей интенсивности, уширению резонансного пика и уменьшению его высоты.

На рис. 2 представлены вытекающие из (5) графики зависимости высоты  $\langle I_q \rangle_{\text{рез}}$



$$\frac{\langle I_q \rangle_{\text{рез}}}{I_0} \approx \zeta \left( \frac{e^{-N\mu_q^2/2} - 1}{\mu_q^4} + \frac{N}{2\mu_q^2} \right) \quad (7)$$

Рис. 1. Основной дифракционный максимум для  $\text{LiNbO}_3$  при  $E=9.8$  кВ/см,  $N \approx 350$ .

1 — эксперимент [1]; 2, 3 — теория при  $\sigma/l^{(0)}=0$  и 0.045 соответственно.

и полуширины  $\Delta_q$  резонансного пика от числа доменов  $N$  для случая  $\sigma \neq 0$ . При условии  $N\mu_q^2 \gg 1$  (но  $|\xi|_* N \ll 1$ ) резонансный максимум описывается формулой

$$\frac{\langle I_q \rangle}{I_0} \approx \zeta \frac{N\mu_q^2}{2(\mu_q^4 + 4\epsilon_q^2)}. \quad (8)$$

Отсюда следует, что с возрастанием числа доменов  $N$  квадратичная зависимость  $\langle I_q \rangle_{\text{рез}}$  от  $N$  (см. (7) при  $N\mu_q^2 \ll 1$ ) меняется на линейную,

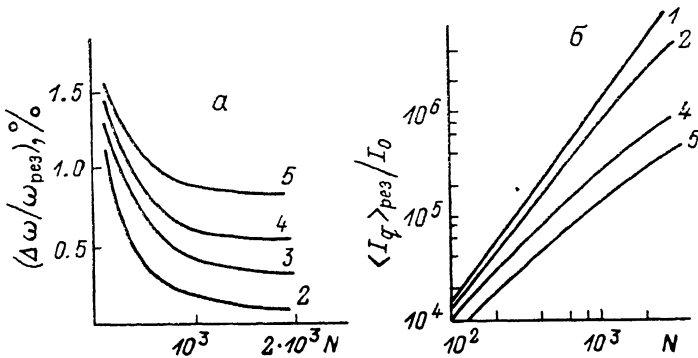


Рис. 2. Зависимость полуширины (а) и высоты (б) основного дифракционного максимума от числа доменов  $N$ .

$\sigma/l^{(0)}$ : 1 — 0, 2 — 0.01, 3 — 0.03, 4 — 0.04, 5 — 0.05.

а полуширина  $\Delta_q$  перестает зависеть от  $N$ , асимптотически стремясь к  $\mu_q^2/2$ . Заметим, что кривые на рис. 2 носят универсальный характер в том смысле, что они зависят лишь от параметров  $N$ ,  $\sigma/l^{(0)}$  и не зависят от материальных констант среды (то же относится и к рис. 3).

Следует отметить, что при  $\sigma \neq 0$  дополнительное понижение и уширение резонансного пика происходит, согласно (5), (6), с возрастанием порядка  $s$  дифракционного максимума (рис. 3), тогда как в предположе-

<sup>4</sup> Пользуясь случаем, укажем на опечатки, допущенные в [1]. На рис. 2 [1] приведена кривая для интенсивности волны, а не для амплитуды — соответственно все величины по оси ординат следует возвести в квадрат. Кроме того, в формуле (8) пропущена мнимая единица перед  $\omega$ , а в формуле (16) необходимо заменить  $\sin(m/2)$  на  $\sin(\epsilon/2)$ .

нии  $\sigma=0$  дифракционные максимумы строго периодичны. Данное обстоятельство имеет простое физическое объяснение, заключающееся в том, что с ростом  $s$  падает величина резонансной длины волны  $\lambda_{\text{рез}} \approx 2\pi v^{(02)}/\omega_{\text{рез}}$  (см. (4)) и неидеальность РДС (т. е. разброс толщин доменов) вносит все более заметный вклад.

Полученные в настоящей работе формулы в точности сохраняются для случая электромагнитных волн, распространяющихся через РДС в немагнитном, негиротропном, прозрачном кристалле, если в них положить  $q=2$  (индекс «1» по-прежнему относим к собственной (при  $E=0$ ) моде, возбуждаемой на входе РДС) и параметр  $\Omega_q$  задать в виде  $\Omega_q = \pi c/l^{(0)} |\Delta n|$ ,

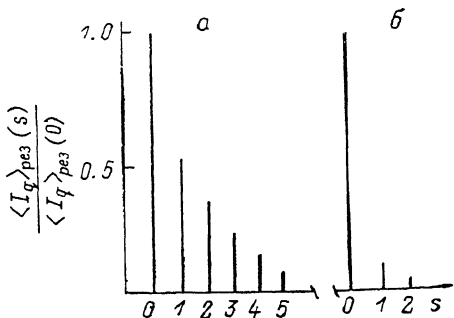


Рис. 3. Зависимость высоты резонансного пика интенсивности от порядка  $s$  дифракционного максимума.

$a - \sigma/l^{(0)} = 0.01$ ,  $b - 0.05$ .  $N = 400$ .

где  $\Delta n = n^{(01)} - n^{(02)}$ ,  $n^{(02)}$  — показатели преломления волн  $\alpha=1, 2$  при  $E=0$ ,  $c$  — скорость света. В частности, выражение (4) можно представить в виде

$$\lambda_{\text{рез}} = 2 |\Delta n| l^{(0)} / (1 + 2s). \quad (9)$$

Отсюда, например, для танталата лития следует, что при  $l^{(0)} \approx 50$  мкм основной дифракционный максимум ( $s=0$ ) будет наблюдаться в видимом диапазоне  $\lambda_{\text{рез}} \approx 0.5$  мкм.

#### Л и т е р а т у р а

- [1] Альшиц В. И., Антипов В. В., Сорокин Н. Г. и др. // Изв. АН СССР, сер. физ. 1987. Т. 51. № 10. С. 1733—1741.  
 [2] Барковский Л. М., Федоров Ф. И. // ДАН СССР. 1974. Т. 218, № 6. С. 1313—1316.  
 [3] Барковский Л. М., Борздов Г. Н. // Опт. и спектр. 1975. Т. 39. № 1. С. 150—154.

Институт кристаллографии АН СССР  
Москва

Поступило в Редакцию  
26 июля 1988 г.